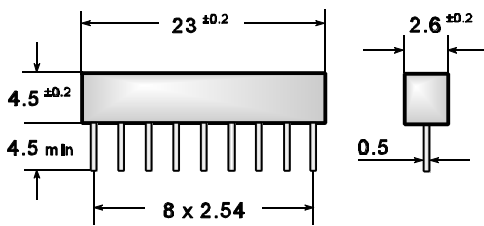


**Rectifier Arrays**
**Gleichrichter Sätze**


Nominal power dissipation 1.2 W  
 Nenn-Verlustleistung

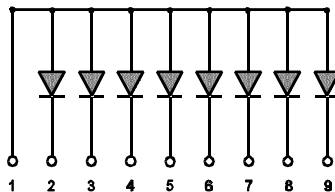
Repetitive peak reverse voltage 100...1000 V  
 Periodische Spitzensperrspannung

9 Pin-Plastic case 23 x 2.6 x 4.5 [mm]  
 9 Pin-Kunststoffgehäuse

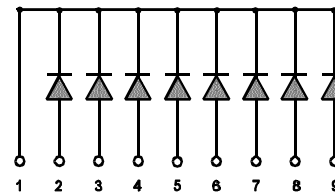
Dimensions / Maße in mm

Standard packaging: bulk  
 Standard Lieferform: lose im Karton

Weight approx. 0,6 g  
 Gewicht ca.



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anode



"DA 811 K...8110 K" : com. kathodes / gem. Kathode

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Typ	Periodische Spitzensperrspannung	Stoßspitzensperrspannung
	$V_{RRM}$ [V]	$V_{RSM}$ [V]
DA 811 A/K	100	120
DA 814 A/K	400	480
DA 8110 A/K	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load, For one diode operation only For all diodes together	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	600 mA <sup>1)</sup> 150 mA <sup>1)</sup>
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, Nur eine Diode im Einsatz Für alle Dioden zusammen	$T_U = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	600 mA <sup>1)</sup> 150 mA <sup>1)</sup>
Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, superimposed on rated load, one diode only Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast, für eine Diode	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	30 A

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	$1.2 \text{ W}^1)$
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	$-50\dots+150^\circ\text{C}$

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1 \text{ A}$	$V_F$	$< 1.1 \text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	$I_R$ $I_R$	$< 10 \mu\text{A}$ $< 90 \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{\text{thA}}$	$< 85 \text{ K/W}^1)$

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden